

会议简讯

第三届全国半导体物理会议

第三届全国半导体物理会议于1981年12月15日至19日在江苏省无锡市召开。出席这次会议的有领导部门、高等院校、研究所、工厂等66个单位的133名代表。大会共收到论文摘要180余篇，报告内容涉及电子态、表面、界面、输运现象、深能级杂质和缺陷、非晶态、半导体光学性质、器件物理、离子注入、激光退火和辐射效应等。

代表们认为，这次会议和第二届会议比较，有以下几个特点。表现在，半导体物理的研究面比以前宽了，不少在上次会议是空白的课题，在本次会议有了较为深入的工作报告；会议首次有了一批本国研究生的工作报告，共21篇，占全部报告的20%以上，而且报告都有较好的水平，反映了我国年青一代科学工作者正在迅速成长，他们是我国科技队伍的一支重要生力军；此外，会议还有一批和国外学者合作的研究成果，介绍了国外的研究动向。

代表们认为我国半导体物理的研究工作和国际先进水平相比，还有不少差距。我们开展工作的面还是比较窄的，有些很重要的研究半导体性质的实验方法我们还没有建立。即使和国内半导体研究的其它领域相比，也是一个薄弱环节。代表们希望，有关领导部门能重视半导体物理这一具有很强应用背景的基础学科，加强对它的领导和支持。

下一次会议预定在1983年举行。代表们建议，下一次会议由南京大学和1425所负责主办。

(屈逢源)

Third National Conference on Physics of Semiconductors

Wuxi, 15—19, Dec. 1981

第二届《全国集成电路和硅材料学术年会》

由中国电子学会半导体与集成技术学会和电子材料学学会联合主办的第二届《全国集成电路和硅材料学术年会》已于一九八一年十二月十二日至十七日在广州召开。出席会议的代表有370名。

年会收到学术论文报告330篇，其中263篇分别在硅材料质量研究、硅材料物理及测试，双极电路、MOS电路、集成电路工艺、CAD测试与专用设备、工艺监控与理论分析、CVD和激光退火等8个分会上进行了交流。王守武、林兰英、王守觉、黄敞在大会上分别作了题为《介绍国外大规模和超大规模集成电路的工艺状况》、《直拉硅单晶中的原生漩涡缺陷的透射电镜观察》、《集成线性逻辑电路及其应用》、《八十年代集成电路研究、试制、生产的展望及建议》的报告。本届学术年会是继1979年12月在福州召开的第一届《全国集成电路和硅材料学术年会》之后的又一次盛会，会上交流了我国近两年来在集成电路和硅材料领域的研制、生产情况和学术发展动态。代表们满意地看到了在集成电路和硅材料方面取得的一批成果和可喜的进展。